

讣告



中国共产党优秀党员、中国科学院院士，中国科学院半导体研究所研究员、我国著名半导体光电子学家王圩先生因病医治无效，不幸于2023年1月26日18点11分在北京逝世，享年86岁。

王圩院士1937年12月25日生于河北文安，1960年毕业于北京大学物理系半导体专业，同年到中国科学院半导体研究所工作至今。他是我国著名的半导体光电子学专家，为我国半导体学科建设、技术创新、产业振兴以及人才培养做出了重要贡献。先后获得国家“六五”攻关奖、中国科学院科学技术进步一等奖、国家科学技术进步二等奖、中国材料研究学会科学技术一等奖等。1997年当选中国科学院院士。

王圩院士在半导体光电子学领域辛勤耕耘、造诣颇深，并取得了一系列重要科研成果。20世纪60年代率先在国内研制成功无位错硅单晶，为我国硅平面型晶体管和集成电路的发展做出了贡献。70年代率先在国内研制成功单异质结室温脉冲大功率激光器和面发射高亮度发光管，并成功应用于夜视、引信、打靶和精密测距仪上；参与建立了国内首批Ⅲ-V族化合物液相外延方法，为国内首次研制成功GaAs基短波长脉冲激光器奠定基础。80年代至90年代研制成功1.3微米/1.5微米激光器和应变量子阱动态单模分布反馈激光器，为我国提供了用于研发第二、第三代长途大容量光纤通信急需的光源。进入新世纪以来，主持开展大应变量子阱材料以及不同带隙量子阱材料的单片集成等关键技术的研究，建立了可集成半导体激光器、电吸收调制器、光放大器、探测器以及耦合器等部件的集成技术平台，为

开展多个光学部件的单片集成技术奠定了基础。

王圩院士一生热爱党、热爱祖国、热爱科学事业！他一生勤奋不辍、学风严谨、务实求真、锐意创新，倾其毕生精力投身于半导体光电科学事业！他严于律己，忠厚宽容，身先士卒，淡泊名利。他的逝世，是我国科学界和教育界的重大损失！他的精神，将激励后人奋进前行！他的业绩和品德，将为中国科技事业树立一座不朽的丰碑。对王圩院士的逝世，我们表示深切的哀悼！

王圩院士永垂不朽！王圩院士精神永存！

谨此讣告。

王圩院士治丧委员会

2023年1月26日